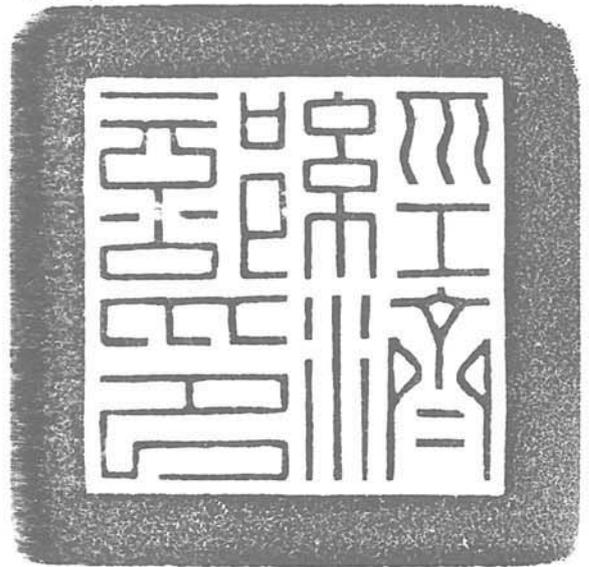


檔 號：
保存年限：

經濟部 公告

發文日期：中華民國112年12月22日
發文字號：經授產字第11251043110號
附件：如文



主旨：公告本部「產業升級創新平台輔導計畫」項下主題式研發計畫「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」公告事項，自公告之日起正式受理申請。

依據：「經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法」辦理。

公告事項：「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」公告事項詳如附件。

部長 王美花

裝

訂

線

「驅動國內 IC 設計業者先進發展補助計畫」

公告事項

一、計畫目標：

臺灣 IC 設計產業的全球市佔率高居第二位，但面臨歐、美、日、韓及中國等各國紛紛祭出高額補貼或稅賦優惠來傾力扶持本土 IC 設計產業、中國近年全力發展成熟製程等，逐步對我國 IC 設計產業形成重大威脅與挑戰；有鑑於此，政府將協助業者降低先進晶片研發應用之成本與風險，並鼓勵業者投入高值化晶片發展，故而提出「驅動國內 IC 設計業者先進發展補助計畫」(以下簡稱本計畫)。

本計畫推動 IC 設計相關業者協同國內系統業者投入 16 奈米(含以下)晶片應用研發，提升我國先進晶片設計能量，拓展人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)、車用等高值化產品應用市場；另鼓勵業者投入具國際高度信任感之優勢晶片(如資安、通訊、無人機、航太…等)或促進產業發展之特殊晶片(如生醫、農業…等)，且在該領域具有領先/優勢地位；亦將協助業者投入具利基市場之晶片投產；期能拓展我國 IC 設計相關業者商機，降低優勢晶片量產之成本與風險，提升產業投注發展新興應用領域優勢晶片之競爭力，帶動國內業者達成 2028 年臺灣成為優勢晶片供應鏈關鍵供應者之產業願景。

二、補助範疇：

為推動我國 IC 設計業者投入 16 奈米(含)以下或優勢晶片應用研發，以及鼓勵業者投入具利基市場之晶片發展，本計畫補助範疇包含以下兩類型：

(一)先進/優勢/特殊晶片研發：

補助項目包含但不限於光罩(Mask)、矽智財(IP)、下線(Tape out)、晶圓共乘(Shuttle)、電子設計自動化(EDA)等有助於加速晶片商品化之項目，補助上限為新臺幣 2 億元。補助範疇分為兩項，得擇一申請，說明如下：

- 16 奈米(含以下)晶片，結合 AI、高效能運算(HPC)、車用等高值化產品應用市場。
- 具國際高度信任感之優勢晶片(如資安、通訊、無人機、航太…等)或促進產業發展之特殊晶片(如生醫、農業…等)，且在該領域具有領先/優勢地位。

(二)晶片投產：補助項目僅限於光罩(Mask)及晶圓共乘(Shuttle)，補助上限為新臺幣 1 千萬元。補助範疇僅一項，說明如下：

- 小批量或試量產且具利基市場之晶片投產。

三、審查重點：

(一)申請廠商研發實績與執行計畫之研發能力。

1. 先進/優勢/特殊晶片研發：

- 16 奈米(含以下)晶片，結合 AI、高效能運算(HPC)、車用等高值化產品應用市場：對應之相關研發主題，應包含光罩(Mask)、矽智財(IP)、下線(Tape out)、晶圓共乘(Shuttle)、電子設計自動化(EDA)等；應敘述結合相關廠商推出 AI、高效能運算(HPC)或車用等解決方案相關內容。
- 具國際高度信任感之優勢晶片或促進產業發展之特殊晶片，且在該領域具有領先/優勢地位：對應之相關研發主題，應包含光罩(Mask)、矽智財(IP)、下線(Tape out)、晶圓共乘(Shuttle)、電子設計自動化(EDA)等；應敘述結合

相關廠商推出具國際高度信任感且在該領域具有領先/優勢地位之資安、通訊、無人機、航太...等解決方案相關內容，或敘述結合相關廠商推出促進產業發展且在該領域具有領先/優勢地位之生醫、農業...等解決方案相關內容。另針對在相同應用/技術領域中，具領先/優勢地位，需提出國內外技術、市場競爭力之分析比較。

2. 晶片投產：

- 小批量或試量產且具利基市場之晶片投產：應敘述欲開發晶片之功能、晶片預計使用的製程技術、應用產品之商業模式。

(二)計畫時程、實施方法、技術指標、研發項目與研發經費編列之合理性等。

(三)計畫預期產出效益：包含但不限於以下內容。

1. 先進/優勢/特殊晶片研發：

- AI、高效能運算(HPC)、車用等 16 奈米(含)以下晶片之高值化產品應用：提升我國先進晶片設計能量、拓展高值化產品應用市場之相關價值。
- 具國際高度信任感之優勢晶片或促進產業發展之特殊晶片，且在該領域具有領先/優勢地位之晶片開發與應用：投入資安、通訊、無人機、航太、生醫、農業...等解決方案/產品之優勢與國際市場商機。

2. 晶片投產：

- 小批量或試量產且具利基市場之晶片投產：應用產品之競爭力與利基市場商機。

(四)委託研究及無形資產引進之內容與對象之必要性與合理性。

(五)計畫期程：「先進/優勢/特殊晶片研發」以不超過 3 年為原則；「晶片投產」以不超過 2 年為原則。由本部籌組專業審查小組進行審查(專家小組得視需要至現場訪視)，核定通過後簽約執行，計畫執行期程可回溯至 113 年 4 月 1 日。

四、補助資格：本計畫以補助我國 IC 設計相關業者為主，由單一企業提出申請，申請廠商應同時符合下列事項：

(一) 國內依法登記成立之本國公司，含獨資、合夥、有限合夥事業或公司，本國公司之認定：

1. 若本國公司為外國公司依中華民國公司法在臺登記之分公司、或本國公司為外國公司之從屬公司，非屬本計畫認定之本國公司。

2. 若原依中華民國公司法在臺設立登記之本國公司，後因公司營運發展將部份業務轉移至國外或更改股權結構成為外國公司之從屬公司，但仍於中華民國境內進行主要營運與研發者，視為本計畫認定之本國公司。

(二) 非屬銀行拒絕往來戶，且公司淨值(股東權益)為正值。

(三) 不得為陸資來臺投資企業；其依經濟部投資審議司之陸資來臺投資事業名錄認定之。

(四) IC 設計相關業者包括：從事 IC 設計、IC 設計服務、矽智財、EDA 相關業者，且須提供服務實績進行佐證。

五、作業須知：

(一) 補助比例以計畫全程總經費 50% 為上限，其餘部分由申請單位自籌。

(二) 補助科目依「經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法」公告項目。

- (三) 申請之企業應具備從事研究發展所需之人力與專案執行及管理能力並有實際績效，足以進行申請計畫之產業技術研發。
- (四) 申請公司於五年內未曾有執行政府科技計畫之重大違約紀錄，及未有因執行政府科技計畫受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。
- (五) 計畫書應載明事項包括公司概況及研發能力實績、需求與應用分析及競爭分析、計畫目標與執行架構、關鍵能力分析、後續成果落實可行性規劃及市場藍圖等。
- (六) 本計畫申請須知、經費編列範圍及計畫管理作業手冊等規範比照產業升級創新平台輔導計畫規定辦理。

六、申請程序：

申請本專案計畫者，應於公告受理期間研送計畫書，受理日期自公告日起至 113 年 3 月 29 日下午五點止(親送或郵寄，郵寄日期以交郵當日郵戳為憑；地址：台北市信義路三段 41-2 號 10 樓)。

七、其他注意事項：

- (一) 本計畫採批次收件、批次審查，依最終評核結果及推薦順序，擇優對象予以補助。
- (二) 本計畫申請廠商以一案為限，且與「IC 設計攻頂補助計畫」(產業技術司)擇一申請。本計畫主要補助業者研發先進晶片、具國際高度信任感之優勢晶片或促進產業發展之特殊晶片、小批量或試量產且具利基市場之晶片投產，推動創

新應用產品化與落地，產業技術司則主要補助大廠攻頂，包括先進製程、新興技術等的國際領先。

- (三) 本公告未盡事宜，應依「經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法」及其他相關法令規定辦理。
- (四) 申請應備資料：
1. 計畫申請表、申請公司基本資料表。
 2. 所提計畫書之各項內容，須齊備申請公司之資料。
 3. 申請公司應於申請計畫時檢附最近3年會計師簽證之查核報告書(若為影本須加蓋公司大小章)。公司於計畫申請當年度始登記成立者，得以公司設立登記資本額查核報告書，以及最近一期會計師期中查核/核閱報告或申請前一個月之自編財務報表代替。
- (五) 參與公司須派員出席審查會議並須接受財務審查。視需要本署得召開實地查證會議，廠商須派員出席。
- (六) 審查通過之計畫，由申請公司與本署委託之機構簽約。計畫執行期間，本署委託之機構得對執行計畫之申請公司進行查證作業。
- (七) 政府補助款由本部委託之機構撥付申請公司，該公司須設立專戶儲存補助款。
- (八) 申請公司於計畫結束後應配合本署計畫成果展示宣導活動，並協助提供成果運用、投資金額、創造產值等計畫成效資料。
- (九) 無形資產/技術引進應註明是否為政府計畫成果，若是，則該無形資產引進應編列於自籌款；委託研究亦應標註是否為政府計畫成果，若是，須註明該政府計畫名稱並說明本申請計畫委託之技術項目與該政府計畫技術之區別。

(十) 本計畫優先支持採用國內 IP，且研發投產之晶圓共乘(shuttle)對象須為國內晶圓廠，如有特殊需求者，請敘明理由。為促進我國半導體產業鏈發展，本計畫亦鼓勵申請企業與其上下游業者合作。